

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 61001042
PUBLICATION DATE : 07-01-86

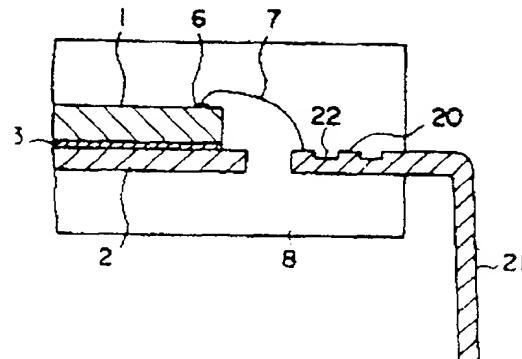
APPLICATION DATE : 13-06-84
APPLICATION NUMBER : 59121486

APPLICANT : TOSHIBA CORP;

INVENTOR : KATAGIRI MASARU;

INT.CL. : H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE : SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT : PURPOSE: To eliminate the exfoliation of a sealer by improving the sealability of the sealer by utilizing the variation in the thickness of internal leads, thereby eliminating the removal of external leads.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 1 is die bonded to a bed 2 of a lead frame, internal leads 20 arranged around the bed 2 are connected with electrodes through metal wirings 7 on the chip 1, and sealed by thermosetting resin 8. External leads 21 continued to the leads 20 are formed out of the resin 8. In this case, a recess 22 is formed on the leads 20. Recesses and projections may be alternately formed on both ends of the leads 20 instead of the recess 22, and a projection may be formed on the leads 20. The above recess or projection is engaged with the resin at the inner leads to increase the contacting area. Accordingly, the leads are hardly removed, and moisture is hardly invaded.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
⑪ 公開特許公報 (A) 昭61-1042

⑫ Int.Cl. 1 識別記号 厅内整理番号 ⑬ 公開 昭和61年(1986)1月7日
H 01 L 23/48 23/28 7357-5F
7738-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

⑭ 発明の名称 半導体装置

⑮ 特 願 昭59-121486
⑯ 出 願 昭59(1984)6月13日

⑰ 発明者 南 健 治 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内
⑱ 発明者 片 堀 優 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内
⑲ 出願人 株式会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地
⑳ 代理人 弁理士 猪股 清 外3名

明細書

1. 発明の名称 半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 半導体チップと、

この半導体チップの周囲に配設されて前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの接続部分以外に厚さが変化する部分を設けた内部リードと、

この内部リードおよび前記集積回路チップを気密状態で封止する封止体と、

この封止体から外部に延出し、前記内部リードと連続した外部リードと、

を備えた半導体装置。

2. 厚さ変化部分が凹部である特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. 凹部が内部リードの両面に形成されたものである特許請求の範囲第2項記載の半導体装置。

4. 凹部がコインシングにより形成されたもの

である特許請求の範囲第2項記載の半導体装置。

5. 厚さ変化部分が凸部である特許請求の範囲第1項記載の半導体装置の外周部。

6. 凸部が内部リードの両面に形成されたものである特許請求の範囲第5項記載の半導体装置。

7. 凸部がめっきにより形成されたものである特許請求の範囲第5項記載の半導体装置。

8. 半導体チップと、

この半導体チップの周囲に配設されて前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの接続部分以外に幅および厚さが変化する部分を設けた内部リードと、

この内部リードおよび前記半導体チップを気密状態で封止する封止体と、

この封止体から外部に延出し、前記内部リードと連続した外部リードと、

を備えた半導体装置。

9. 幅変化部分が内部リードに形成された貫通孔である特許請求の範囲第8項記載の半導体装置。

特開昭61-1042(2)

10. 幅変化部分が切欠き部である特許請求の範囲第8項記載の半導体装置。

11. 幅変化部分が突起部である特許請求の範囲第8項記載の半導体装置。

12. 幅変化部分が屈曲部である特許請求の範囲第8項記載の半導体装置。

13. 厚さ変化部分が凸部である特許請求の範囲第8項ないし第12項記載の半導体装置。
のいぞれか

14. 厚さ変化部分が凹部である特許請求の範囲第8項ないし第12項記載の半導体装置。
のいぞれか

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体装置に係り、特に樹脂封止パッケージ、低融点ガラス封止パッケージ等の封止型外囲器を備えたものに関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

半導体装置の外囲器としては、リードフレーム用い半導体チップとのワイヤボンディングを行った後封止を行う封止型のものが品質と信頼性の

向上と相俟って從来セラミックパッケージを使用していた分野にも広く使用されるようになってい
る。封止型のパッケージには、ワイヤボンディング完了後のリードフレームを型の中に入れ熱硬化性
プラスチック樹脂でモールドする樹脂封止型のものと、セラミック基板の上に搭載したワイヤボ
ンディング後の集積回路チップを低融点ガラスで
封止しキャップで被うサーティップパッケージが
あり、後者は特に大电流の流れるチップに適用さ
れる。

これらの封止型パッケージでは封止が完全に行
われて外部リードの抜けがなく、また外部リード
と封止材の境界部にはがれ等による空隙が発生し
ないことが要求される。

すなわち、半導体装置は第5図の断面図に示す
ように集積回路チップ1はリードフレームのベ
ッド部2に導電性接着剤3等によりタイボンディン
グされており、ベッド部2の周縁に配設された内
部リード4と集積回路チップ1上の沿板らとは金
またはアルミニウム等の金属ワイヤで接続され

ており、これらは熱硬化性樹脂8により封止され
ている。この樹脂封止体の外部に延出したリード
は外部リードと称され、例えばプリント基板との
接続に使用される。

近年、樹脂封止技術は著しく改善され、信頼性
が向上しているが、それでもリードと樹脂との密
着性が悪かったり、両者の熱膨脹率が著しく相違
した場合には第5図に示すようにはがれりが生じ
このためリード4、5が抜けやすくなり、またこ
のはがれり部を通じて空気中の水分が外囲器内部
に侵入し半導体装置の信頼性を著しく低下させる。

このため、リード抜けを防止し、耐湿性を向上
させる目的で内部リードの形状について種々の提
案がなされている。

第6図は從来の内部リード4の形状を示す平面
図であって、第6図(a)は内部リードに丸穴
11を開孔させたもの、第6図(b)は突起部
12を設けたもの、第6図(c)は切欠き部13
を設けたもの、第6図(d)は屈曲部14を設け
たものである。このような形状の採用により樹脂

とリードの密着性が向上し引張強度および耐湿性
の向上を図ることができる。

しかしながら、このような形状を採用しても符
合する耐湿性に関しては不充分な場合がある。また、
半導体装置の高集成化に伴ない、内部リードの幅
についての制限が厳しくなっており、特に第6図
(c)および(d)のような形状を採用することは困
難である。

(発明の目的)

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、リ
ードの抜けがなく、また、耐湿性のすぐれた半導
体装置を提供することを目的とする。

(発明の概要)

上記目的達成のため、本発明においては半導体
チップと、この半導体チップの周縁に配設されて
前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チ
ップとの接続部分以外に厚さが変化する部分を設
けた内部リードと、この内部リードおよび前記集
積回路チップを気密状態で封止する封止体と、こ
の封止体から外部に延出し、前記内部リードを通

特開昭61-1042(3)

続した外部リードと、を備えた半導体装置を備えており、耐湿性の優れた高分子積化半導体装置を得ることができるものである。

また、他の本発明においては、半導体チップと、この半導体チップの周囲に配設されて前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの接続部分以外に幅および厚さが変化する部分を設けた内部リードと、を備えており、耐湿性のさらに優れた半導体装置を得ることができるものである。

(発明の実施例)

以下、図面を参照しながら本発明の実施例のいくつかを詳細に説明する。

第1図は本発明にかかる半導体装置の構成を示す断面図であって、第5図と同様、半導体チップ1はリードフレームのベッド部2に導電性接着剤3等によりダイボンディングされ、ベッド部2の周囲に配設された内部リード20は半導体チップ1上の電極6と金属ワイヤ7により接続されており、これらは熱硬化性樹脂8により封止されている。樹脂8外には内部リード20に連続した外部

リード21が設けられている。この次発例においては内部リード20に凹部22が形成されている。この凹部22はリード厚250μに対し50μの程度である。

第2図および第3図は他の実施例を示す断面図であって、内部リード部分を中心にして描いてある。

第2図においては内部リード20の両面に凹部22および23が交互に形成されている。

このような凹部は各種の方法で形成することができるが、一般的にはリードフレームをプレスで打抜く際に型を用いたコインシングを行う方法と、エッチングでリードフレームを抜く際に所望部分をさらにエッチングする方法が採用される。

第3図は内部リード20上に凸部24を設けて厚さを変化させたものである。この凸部24はめっき、溶射等により金属を付着させることによって形成される。

以上のような凹部あるいは凸部は樹脂と内部リードをかみ合わせ、また接触面積を増大させるか

ら、リードは抜けにくくなり、水分が侵入しにくくなつて耐湿性が向上する。

第4図は本発明にかかる半導体装置に使用される内部リード30の種々の実施例の構成を示す平面図であって、断面形状は第2図に示したものであるとして描いてある。第4図(a)では厚さの変化と共にリード幅を変化させる切欠き部31を有している。また第4図(b)では突起部32、第4図(c)では円形孔33が設けられリード幅を変化させている。第4図(d)においては内部リード30自体が底面部34を有しており、リード幅に対し、見かけのリード幅を増大させている。

このように厚さ変化と幅変化を共に有する内部リードでは、樹脂と内部リードの接触面積がさらに増大するため耐湿性をさらに向上させることができる。

以上の実施例においては、樹脂封止型の半導体装置について説明したが、低融ガラスにより封止が行われるいわゆるサーディップパッケージにも適用することができる。

また、厚さ変化部、幅変化部の形状は実施例に示したもののがあらゆる形状を採用することができ、それらの数、大きさも適宜選択することができる。

さらに厚さ変化部は実施例ではリード幅全体にわたっているが、その必要は必ずしもなくリード幅の一部に厚さ変化を設けてよい。

(発明の効果)

以上のように、本発明においては内部リードの厚さ変化を利用して封止体との密着性を向上させているので、高分子積化された封止型半導体装置においても外部リードの抜けを招くことがなく、また封止体のはがれ等が生じないことから耐湿性を向上させることができる。

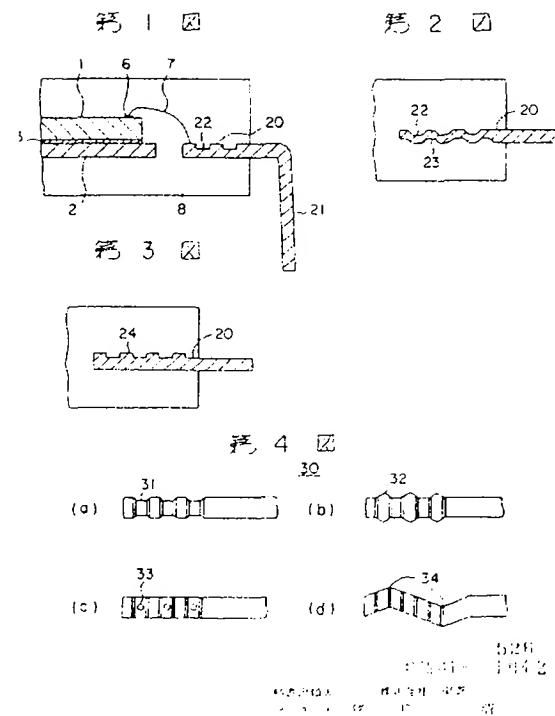
また、内部リードの厚さ変化部と幅変化部を併有する本発明においては、封止体と内部リードの接触面積増大に伴って外部リードの固定と耐湿性をさらに良好にすることができる。

特開昭61-1042(4)

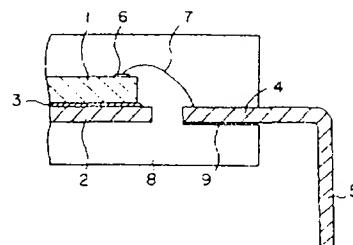
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる半導体装置の構成を示す断面図、第2図および第3図は他の実施例の内部リード部分を示す断面図、第4図は他の本発明にかかる半導体装置に使用される内部リードの構成を示す平面図、第5図は従来の半導体装置の構成と開端点を説明する断面図、第6図は従来の半導体装置に使用される内部リードを示す平面図である。

1…半導体チップ、2…パッケージ部、4、20、
30…内部リード、5、21…外部リード、
22、23…凹部、24…凸部、13、31…切
欠き部、12、32…突起部、11、33…円形
孔、14、34…彎曲部。



5



第 6 図

